

Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт сильноточной электроники
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИСЭ СО РАН)

П Р И К А З

26.08.2025 № 18-обр.

г. Томск

О зачислении в аспирантуру
на основном этапе зачисления

На основании протокола заседания приемной комиссии № 1 от 26 августа 2025 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Джамбулову Томирис зачислить с 01 сентября 2025 года на первый курс очного обучения в аспирантуре на основное бюджетное место в рамках контрольных цифр приема сроком на 4 года по научной специальности 1.3.5. Физическая электроника, и назначить Джамбуловой Т. государственную стипендию с 01 сентября 2025 г. по 31 января 2026 г.

2. Крайнову Елизавету Олеговну зачислить с 01 сентября 2025 года на первый курс очного обучения в аспирантуре на основное бюджетное место в рамках контрольных цифр приема сроком на 4 года по научной специальности 1.3.5. Физическая электроника, и назначить Крайновой Е. О. государственную стипендию с 01 сентября 2025 г. по 31 января 2026 г.

3. Терещенко Илью Алексеевича зачислить с 01 сентября 2025 года на первый курс очного обучения в аспирантуре на основное бюджетное место в рамках контрольных цифр приема сроком на 4 года по научной специальности 1.3.13. Электрофизика, электрофизические установки, и назначить Терещенко И. А. государственную стипендию с 01 сентября 2025 г. по 31 января 2026 г.

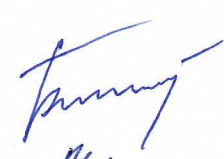
4. Горьковскую Диану Андреевну зачислить с 01 сентября 2025 года на первый курс очного обучения в аспирантуре на основное бюджетное место в рамках контрольных цифр приема сроком на 4 года по научной специальности 2.2.1. Вакуумная и плазменная электроника, и назначить Горьковской Д. А. государственную стипендию с 01 сентября 2025 г. по 31 января 2026 г.

Врио директора института


В. В. Черкасов

Визы:

Зам. директора по НР


А. В. Батраков

Руководитель ООД


И. В. Пегель